

基本信息



姓名：施敏
 性别：男
 籍贯：南京市
 出生日期：1936年3月
 逝世日期：2023年11月6日

当选信息：
 1998年 中国工程院
 所属学部：
 中国工程院
 美国国家工程院

院士简介

工程和技术学领域的成就

在半导体设备，尤其是半导体接触，微波器件和金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）技术的研发中，施博士的贡献具有奠基性和开创性的意义。尤其是他参与研发的非易失性半导体存储器（NVSM），影响深远，随之诞生了包括闪存存储器和电可擦只读存储器（EEPROM）在内的大量储存设备。NVSM的问世，促成了功能更为强大的信息储存技术的发展，它们应用广泛，人类受益无穷。基于NVSM的系统提供了更便捷的沟通（如：移动电话），更方便的信息接收（便携式笔记本电脑和个人数字助理），互动性更强的教育（数字化教学媒体和电子图书），增强的贸易（智能IC卡系统），提高的卫生保健（便携式医疗仪器），更富于魅力的娱乐方式（MP3，数码电视与DVD），以及极大改观的行车安全（自动刹车系统和全球定位系统）。1990年以来，所有的电子系统（除家用收音机和阴极射线管电视）都是建立在NVSM2基础之上。过去的20年里，装运发货的基于NVSM系统超过了200亿套。未来10年里，这一数字累计将达600亿。这也就意味着，全世界平均每人将拥有8个基于NVSM电子系统。

主要学历

1950年 - 1953年 台湾建国中学
 1953年 - 1957年 国立台湾大学 电机工程系 学士
 1958年 - 1960年 美国华盛顿大学 电机工程系 硕士
 1960年 - 1963年 美国斯坦福大学 电机工程系 博士

主要经历

1963年 - 1989年 贝尔实验室 研究员
 1969年 环宇电子股份有限公司 技术顾问
 1990年 台湾交通大学电子工程学系、电子与咨询研究中心 教授、主任
 1998年 - 2004年 台湾奈米元件实验室 主任
 2004年 台湾奈米元件实验室 资深顾问

本资料由中国工程院院士馆提供

